Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0200U001276

Державний реєстраційний номер: 0195U024512

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-02-2000

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Комплексні дослідження впливу міждефектної взаємодії в кристалах Si, Ge, GaAs, КРТ і МРТ на кінетику електронних процесів в термодинамічно рівноважних і нерівноважних умовах.

Початок етапу: 01.1995

Закінчення етапу: 12.1999

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (044) 265-62-80

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Комплексні дослідження впливу міждефектної взаємодії в кристалах Si, Ge, GaAs, КРТ і МРТ на кінетику електронних процесів в термодинамічно рівноважних і нерівноважних умовах.

Назва роботи англійською:

Complex investigations of interdefects interaction in Si, Ge, GaAs, CdHgTe, MnHgTe crystals on kinetics of electron processes of thermodynamic equilibrium and nonequilibrium conditions

Реферат українською:

В цьому звіті зроблено спробу описати результати досліджень транспортних явищ, структурної досконалості , фотопровідності та фотолюмінесценції в технічно актуальних напівпровідниках, таких як Si, Ge, GaAs, CdHgTe, MnHgTe при різних зовнішніх умовах (за значеннями Т, Н, Е та ін.).

Реферат англійською:

In this account is an attempt to describe our results in the study of transport phenomena, structural perfections, photoconductivity and photoluminescence in technically important semiconductors, such as Si, Ge, GaAs, CdHgTe, MnHgTe at different external conditions (at different values of T, H, E etc.)

Індекс УДК: 621.315.592, 539.2; 539.219.1; 621.785.3

Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Баранський П.І.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Datsenko L., Misiuk A.,Khrupa V., Bak-Misiuk J.,Hдrtwig J.,Domogala J.,Surma B. X-ray studies of influence of hard-static compression on the formation of Oxygen clusters in Si crystals, grown by the Czochralski method, at 1000 K// Metal Physics and Advanced technologies.-1998.-17.N5.-pp.521-528; Datsenko L.,Khrupa V.,Krasulya S., Misiuk

A.,Ндrtwig J., Surma B. Structural perfection of Czochralski grown Si crystals annealed above 1500 K under hydrostatic pressure// Acta .Phys. Polon. A.- 1997.-91, N5.-pp.929-933; Auleytner J.,Datsenko L.,Kla'dko V.,Machulin V.,Melnyk V., Prokopenko I., Bak-Misiuk J., Misiuk A. Influence of hydrostatic pressure at temperatues about 1550 K on defect structure of Czochralski Si// Journ. Alloys and Compounds -1999.-286.-pp.246-249; Glinchuk K.D., Litovchenko N.M., Prokhorovich A.V., Strilchuk O.N. Analysis of the low-temperature (77 K) near-band-edge luminescence in undoped semi-insulating GaAs // Phys.stat.sol.(b). - 1999.-213, N1.-P.233-241; Glinchuk K.D., Prokhorovich A

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Свєчніков С.В.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

